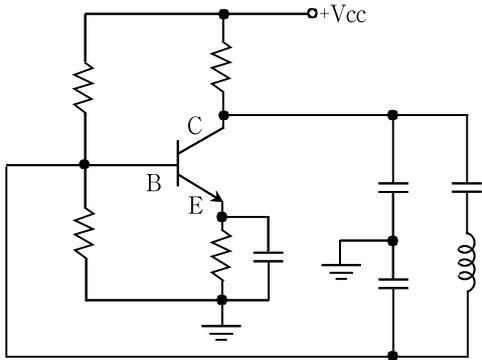


전자공학개론

문 1. QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 변조 방식에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

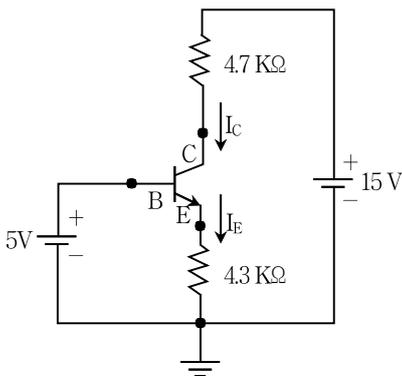
- ① ASK 방식과 FSK 방식을 혼합한 것이다.
- ② FSK 방식의 일종이다.
- ③ ASK 방식과 PSK 방식을 혼합한 것이다.
- ④ FSK 방식과 PSK 방식을 혼합한 것이다.

문 2. 다음 발진기의 명칭은?



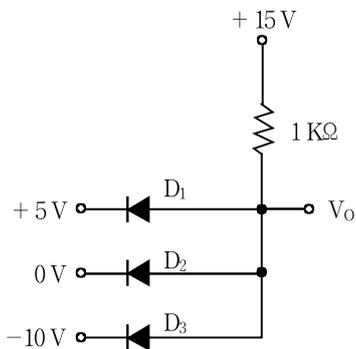
- ① 클랩 발진기
- ② 콜피츠 발진기
- ③ 하틀리 발진기
- ④ 이완 발진기

문 3. 다음 회로에서 BJT의 β 가 아주 클 때, V_{CE} 값[V]에 가장 근접한 것은? (단, $V_{BE} = 0.7V$, $I_C \approx I_E$ 이다)



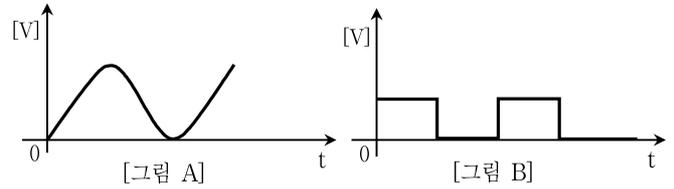
- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

문 4. 다음 회로에서 출력전압 V_O 값[V]은? (단, 회로에서 사용된 다이오드는 이상적인 동작 특성을 갖는 것으로 가정한다)



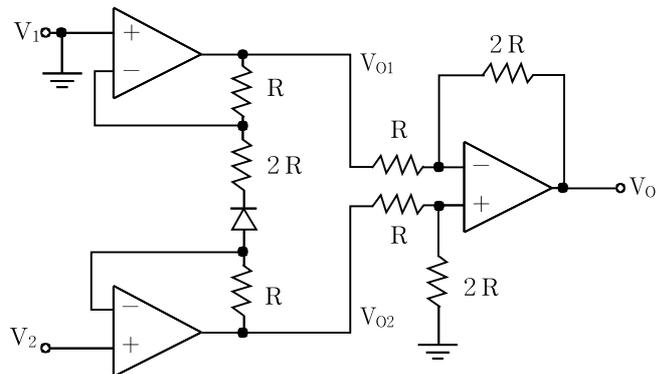
- ① 0
- ② 5
- ③ -10
- ④ 15

문 5. 다음 [그림 A]의 정현파를 [그림 B]의 구형파로 변환시키는데 가장 적합한 회로는?



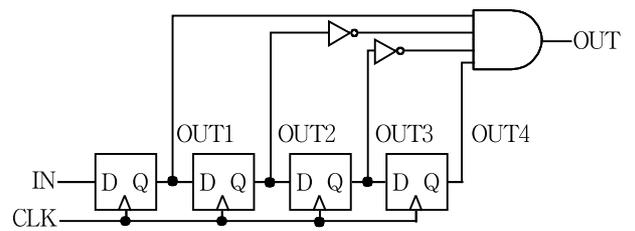
- ① 부스트랩 회로
- ② 블로킹 발진기
- ③ 슈미트 트리거
- ④ LC동조회로

문 6. 다음 회로에서 입력전압 V_2 가 $-1V$ 일 때, 출력전압 V_O 값[V]은? (단, 회로에서 사용된 op-amp와 다이오드는 이상적인 동작 특성을 갖는 것으로 가정한다)



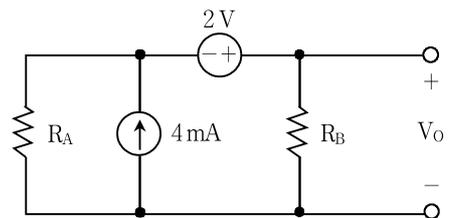
- ① -2
- ② -4
- ③ 2
- ④ 4

문 7. D-F/F을 사용한 다음 회로에서 IN에 "H"→"H"→"L"→"L"→"H"→"H"의 논리값이 순차적으로 입력되면 OUT의 상태가 순차적으로 어떻게 변하는가? (단, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 노드들의 초기값은 모두 "L"이며, IN에 입력되는 논리값 시간 간격은 CLK 신호 주기와 같다고 가정한다)



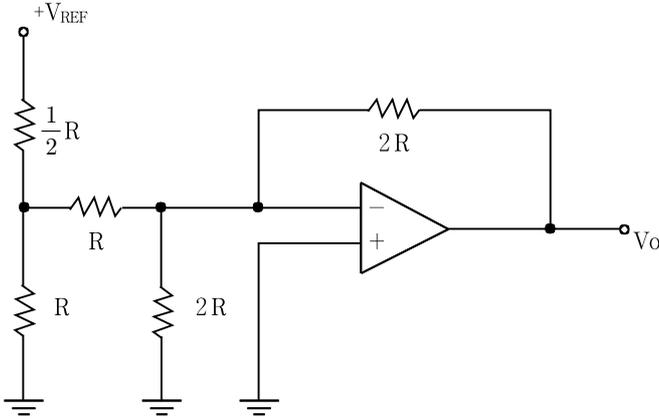
- ① "L" → "H" → "L" → "L" → "H" → "L"
- ② "L" → "L" → "H" → "H" → "L" → "L"
- ③ "H" → "H" → "L" → "L" → "H" → "H"
- ④ "L" → "L" → "L" → "L" → "H" → "L"

문 8. 다음 회로에서 출력전압 V_O 값[V]은? (단, $R_A = 4K\Omega$, $R_B = 8K\Omega$ 이다)



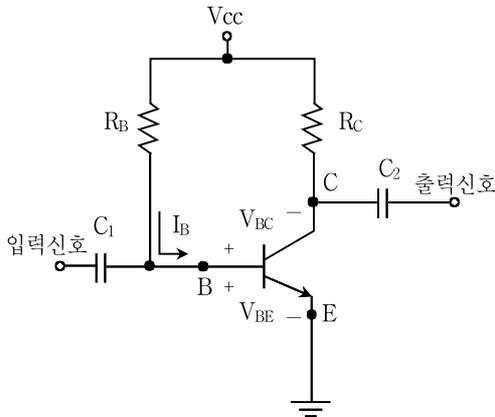
- ① 4
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12

문 9. 다음 회로의 출력전압 V_o 값[V]은? (단, 회로에서 사용된 op-amp는 이상적인 동작 특성을 갖는 것으로 가정한다)



- ① $-V_{REF}/2$
- ② $-V_{REF}$
- ③ $-2V_{REF}$
- ④ $-4V_{REF}$

문 10. 다음 신호증폭용 바이폴라 트랜지스터(BJT)의 고정 바이어스 회로에서, 베이스-콜렉터간 전압값(V_{BC})이 $-6V$ 가 되기 위한 바이어스 저항 R_C 의 값[K Ω]은? (단, BJT의 $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7V$, $R_B = 200K\Omega$, $C_1 = C_2 = 10\mu F$, $V_{CC} = 10.7V$ 이다)



- ① 0.8
- ② 1.2
- ③ 3.3
- ④ 3.5

문 11. 다음 카르노맵(Karnaugh map)을 간략화하여 나타낸 논리식은?

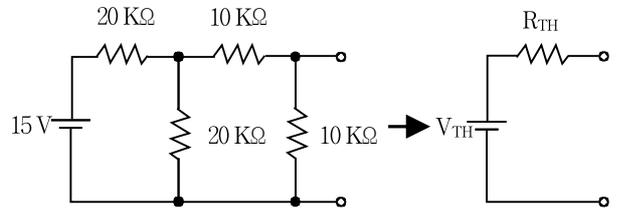
AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

- ① $A'B'C' + ABD + B'CD'$
- ② $A'B'C' + BD + B'D'$
- ③ $A'B'C'D + A'BD + B'D'$
- ④ $A'B'C'D + AB'D' + BD$

문 12. N형 MOSFET에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, MOSFET은 차단영역에 있지 않다고 가정한다)

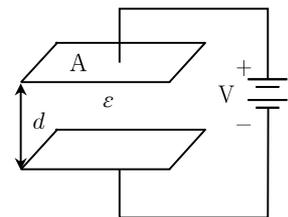
- ① MOSFET 드레인(drain)에 흐르는 전류량은 동일 조건에서 소자의 채널길이(channel length)가 작아지면 증가한다.
- ② MOSFET 드레인(drain)에 흐르는 전류량은 온도에 영향을 받지 않는다.
- ③ MOSFET가 포화영역에서 동작할 때, 유효채널길이(effective channel length)는 드레인-소스(drain-source) 사이의 전압(V_{DS})에 따라서 변할 수 있다.
- ④ MOSFET의 문턱전압(threshold voltage)은 소스-바디(source-body) 사이의 전압(V_{SB})에 따라서 변할 수 있다.

문 13. 테브난 정리를 이용하여 다음 회로를 단순화할 때, 테브난 전압(V_{TH}) [V]과 테브난 저항(R_{TH}) 값[K Ω]은?



- | | | |
|---|----------|----------|
| | V_{TH} | R_{TH} |
| ① | 2.5 | 20/3 |
| ② | 2.5 | 10 |
| ③ | 5 | 20/3 |
| ④ | 5 | 10 |

문 14. 면적이 A인 평행한 두 금속판 사이의 거리가 d인 커패시터의 정전용량을 2배로 증가시키기 위한 방법으로 적절한 것은?



- ① 두 금속판 사이의 거리(d)를 2배로 늘려준다.
- ② 두 금속판의 면적(A)을 2배로 늘려준다.
- ③ 두 금속판 사이에 유전율(ϵ)이 1/2인 물질로 채운다.
- ④ 두 금속판의 면적과 두 판 사이의 거리를 동시에 2배로 늘려준다.

문 15. 펄스코드변조(PCM)를 이용하여 1KHz에서 최대 5KHz 사이의 신호를 나이퀴스트율로 표본화하여 변조하려고 할 때, 각 표본이 24-레벨의 정밀도를 가지려면 펄스코드변조의 비트율 [Kbps]은?

- ① 32
- ② 9.6
- ③ 64
- ④ 50

